

Выездная сессия Научного Совета РАН по проблеме
**РАДИАЦИОННАЯ ФИЗИКА ТВЁРДОГО
ТЕЛА**

24-28 ноября 2014

ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСК-2014

Российская Академия Наук
Научный совет по проблеме «Радиационная физика твердого тела»
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики полупроводников им. А.В. РЖАНОВА СО РАН

Бюро Совета

Б. Н. Гощицкий	председатель Совета, ФГБУН ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
А. В. Двуреченский	заместитель председателя Совета, ИФП СО РАН, Новосибирск
А. Г. Залужный	заместитель председателя Совета, НИЯУ «МИФИ», Москва
В. В. Сагарадзе	заместитель председателя Совета, ФГБУН ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
В. Л. Арбузов	ученый секретарь, ФГБУН ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
В. С. Кортов	ФГАОУ ВПО УрФУ, Екатеринбург
Ю. В. Трушин	СПб АУ НОЦНТ РАН, Санкт-Петербург
Н. Ю. Демидович	референт Научного Совета, Президиум РАН, Москва

Члены Совета

Р. А. Андриевский	ИПХФ РАН, Черноголовка
В. Я. Баянкин	ФТИ УрО РАН, Ижевск
С. П. Беляев	ПИЯФ НИЦ КИ, Гатчина
Г.А. Блейхер	НИ ТПУ, Томск
Г. Г. Бондаренко	МИЭМ НИУ ВШЭ, Москва
В. Н. Брудный	НИ ТГУ, Томск
Н. Н. Герасименко	НИУ МИЭТ, Зеленоград
В.В. Дремов	ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ
В.Б. Иванов	ОАО «ВНИИНМ», Москва
Б. А. Калинин	НИЯУ МИФИ, Москва
А. В. Козлов	ОАО «Институт реакторных материалов», Заречный
В. В. Козловский	СПГПУ, Санкт-Петербург
Ю. В. Конобеев	ГНЦ РФФЭИ им. А.И. Лейпунского, Обнинск
Р. Ф. Коноплева	ПИЯФ НИЦ КИ, Гатчина
Е. А. Красиков	НИЦ «Курчатовский институт», Москва
В. П. Кривобоков	НИ ТПУ, Томск
В.Т. Лебедев	ПИЯФ НИЦ КИ, Гатчина
В. С. Неустроев	ГНЦ РФ НИИ Атомных реакторов, Димитровград
В. В. Овчинников	ФГБУН Институт электрофизики УрО РАН,

В. А. Печенкин
В. В. Плохой
В. П. Попов
В. Ф. Реутов
С. В. Рогожкин
Н. Н. Сюткин

В. М. Чернов
Ю. П. Шаркеев

Екатеринбург
ГНЦ РФФЭИ им. А.И. Лейпунского, Обнинск
ФГУП ВНИИТФ, Снежинск
ИФП СО РАН, Новосибирск
ОИЯИ ЛЯР, Дубна
ФГБУ ГНЦ РФ ИТЭФ, Москва
ФГБУН Институт электрофизики УрО РАН,
Екатеринбург
ОАО ВНИИНМ, Москва
ИФПМ СО РАН, Томск

Адреса и контакты:

Институт физики металлов УрО РАН
ГСП-170, ул. С. Ковалевской, 18
г. Екатеринбург, 620219

Арбузов Вадим Леонидович - ученый секретарь НС РФТТ
arbuzov@imp.uran.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики
полупроводников им.А.В.Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН)
проспект академика Лаврентьева, 13
г. Новосибирск, 630090

Тысченко Ида Евгеньевна – контактное лицо в ИФП СО РАН
tys@isp.nsc.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 НОЯБРЯ

День заезда

ВТОРНИК, 25 НОЯБРЯ

Конференц-зал административного корпуса ИФП СО РАН

9⁰⁰ - 10⁰⁰

Регистрация участников НС РФТТ

10⁰⁰ – 10³⁰

Открытие Сессии: Вступительное слово:

А.В.Латышев, Директор ИФП СО РАН, член-корр. РАН

Б.Н. Гощицкий, Председатель НС РФТТ, член-корр.РАН.

10³⁰ – 11⁰⁰

В.П. Попов. Формирование, свойства и применение NV-центров в облученном алмазе. *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН.*

11⁰⁰ – 11¹⁵ - перерыв

11¹⁵ – 11⁴⁵

П.Л. Новиков. Атомная диффузия и рост на структурированной поверхности Si (моделирование). *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН.*

11⁴⁵ – 12¹⁵

И.В. Антонова. «Эффекты, стимулированные ионами высоких энергий, в диэлектрических слоях с нанокристаллами кремния и германия». *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН.*

12⁰⁰ – 14³⁰ – перерыв на обед

14³⁰ – экскурсия в Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (лазер на свободных электронах)

Экскурсия по ИФП СО РАН

СРЕДА, 26 НОЯБРЯ

Конференц-зал административного корпуса ИФП СО РАН

10⁰⁰ – 10⁴⁰

И.Е. Тыщенко. «Ионно-лучевой синтез структур на основе кремния» (по материалам докторской диссертации). *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН.*

10⁴⁰ – 11¹⁰

В.В. Кириенко. «Пассивация дефектов в структурах Si/Ge с квантовыми точками». *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН.*

11¹⁰ – 11²⁵ – перерыв

11²⁵ – 11⁵⁵

Ж.В. Смагина. «Формирование наноструктурированной поверхности Si с использованием ионной имплантации». *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН.*

11⁵⁵ – 12²⁵

С.С. Косолюбов. Применение фокусированных ионных пучков для создания функциональных твердотельных структур. *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН.*

12²⁵ – 14³⁰ – перерыв на обед

14³⁰ – Экскурсия в Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (Лаборатория экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса).

ЧЕТВЕРГ, 27 НОЯБРЯ

Конференц-зал административного корпуса ИФП СО РАН

10⁰⁰ – 12⁰⁰

Обсуждение важнейших результатов, полученных в 2014 году.

12⁰⁰

Закрытие сессии.

15⁰⁰ - Экскурсия в Планетарий (отъезд из ИФП СО РАН в 14⁰⁰)

ПЯТНИЦА, 28 НОЯБРЯ

День отъезда